



SKU: IRF9Z30 Categoría: Misceláneo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

color: color; inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, line-height: 1.6; <p style="margin-bottom: 16px;">Transistor de potencia MOSFET de canal P diseñado para aplicaciones de conmutación y control en equipos de análisis electrónico. Este dispositivo ofrece una resistencia de encendido ultrabaja de 0.14 Ω que minimiza las pérdidas por conducción, permitiendo operación eficiente con corrientes elevadas hasta 18 A. Su encapsulado TO-220AB facilita la integración en diseños de PCB through-hole con disipación térmica directa, resultando ideal para entornos de laboratorio y equipos de prueba como analizadores de circuitos.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">MOSFET canal P con tecnología de óxido metálicoVoltaje drenaje-fuente (V_{DSS}): 50 VCorriente continua de drenaje: 18 A @ 25°CResistencia R_{DS(on)} máxima: 140 mΩ @ 9.3 A, 10 VDisipación de potencia máxima: 74 WCapacitancia de entrada (C_{iss}): 900 pF @ 25 VCarga de compuerta (Q_g): 39 nC @ 10 VVoltaje umbral V_{GS(th)}: 4 V máx. @ 250 μAVoltaje compuerta-fuente máximo: ±20 VRango de temperatura de unión: -55°C ~ 150°C<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="width: 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de FET</div><div style="font-weight: 600; font-size: 1.05em;">Channel MOSFET</div><div style="flex: 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">V_{DSS}</div><div style="font-weight: 600; font-size: 1.05em;">50 V</div><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">V_{GS(th)}</div><div style="font-weight: 600; font-size: 1.05em;">4 V</div><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">V_{DS}</div><div style="font-weight: 600; font-size: 1.05em;">±20 V</div><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">R_{DS(on)}</div><div style="font-weight: 600; font-size: 1.05em;">140 mΩ @ 9.3 A, 10 V</div><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">P_D</div><div style="font-weight: 600; font-size: 1.05em;">74 W</div><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">C_{iss}</div><div style="font-weight: 600; font-size: 1.05em;">900 pF</div><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Q_g</div><div style="font-weight: 600; font-size: 1.05em;">39 nC</div><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">T_j</div><div style="font-weight: 600; font-size: 1.05em;">-55°C ~ 150°C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje through-hole en PCB estándar
Característica 2	Rango operativo -55°C a 150°C de unión
Característica 3	Carga de compuerta 39 nC para conmutación eficiente
Característica 4	Capacitancia de entrada 900 pF controlada
Característica 5	Voltaje de compuerta ±20 V para protección robusta
Característica 6	Encapsulado TO-220AB con disipación térmica optimizada